

SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS CONDUCENTES A TÍTULOS OFICIALES DE DOCTORADO

FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA (R.D. 99/2011)

Curso 2021-2022

Tablas de datos e indicadores.

Tabla 11. Indicadores del programa de doctorado

Elaborado por: Unidad de Evaluación de la Calidad

Destinatario: Responsables académicos del Programa de Doctorado

Fecha de elaboración: MAYO 2023

Indicadores del programa de Doctorado según criterio y curso académico.

Curso	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Código interno	D012	D012	D012	D012	D012	D012	D012	D012	D012
Código RUCT	5600750	5600750	5600750	5600750	5600750	5600750	5600750	5600750	5600750
Plan	FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA	FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA	FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA	FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA	FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA	FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA	FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA	FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA	FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA
Criterio 1. Organización, gestión y desarrollo									
Nº de plazas ofertadas	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Nº de solicitudes presentadas	7	9	11	6	4	7	7	17	12
Nº de estudiantes de nuevo ingreso	5	7	11	6	4	5	6	15	4
Nº total de estudiantes matriculados	5	12	21	26	26	27	29	35	31
Porcentaje de estudiantes extranjeros	20,00%	33,33%	42,86%	46,15%	46,15%	40,74%	37,93%	42,86%	45,16%
Porcentaje de estudiantes procedentes de otras universidades	40,00%	58,33%	52,38%	50,00%	42,31%	40,74%	41,38%	45,71%	45,16%
Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial	20,00%	8,33%	23,81%	19,23%	19,23%	37,04%	27,59%	20,00%	9,68%
Porcentaje de becas de doctorado concedidas en el curso en relación con la matrícula total	-	-	28,57%	23,08%	34,62%	37,04%	48,28%	34,29%	41,94%
Porcentaje de estudiantes que han requerido complementos de formación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcentaje de estudiantes matriculados según línea de investigación	Bioinformática, genómica comparada, evolución de genomas de hongos, Interacción planta-patógeno: 16,67% Estudios de impactos de los escenarios climáticos en la agricultura: 16,67% Materiales y dispositivos para	Bioinformática, genómica comparada, evolución de genomas de hongos, Interacción planta-patógeno: 7,69% Desarrollo experimental de tecnologías fotovoltaicas y termoeléctricas usando Nanotecnología: 7,69%	Bioinformática, genómica comparada, evolución de genomas de hongos, Interacción planta-patógeno: 4,55% Desarrollo experimental de tecnologías fotovoltaicas y termoeléctricas usando Nanotecnología: 4,55%	Bioinformática, genómica comparada, evolución de genomas de hongos, Interacción planta-patógeno: 3,70% Caracterización de dispositivos fotovoltaicos: 3,70% Desarrollo experimental de tecnologías fotovoltaicas y	Bioinformática, genómica comparada, evolución de genomas de hongos, Interacción planta-patógeno: 3,70% Desarrollo experimental de tecnologías fotovoltaicas y termoeléctricas usando Nanotecnología: 3,70%	Análisis de las variaciones interanuales y estacionales: 3,57% Bioinformática, genómica comparada, evolución de genomas de hongos, Interacción planta-patógeno: 3,57% Caracterización DC y RF de dispositivos	Análisis de las variaciones interanuales y estacionales: 3,33% Bioinformática, genómica comparada, evolución de genomas de hongos, Interacción planta-patógeno: 3,33% Caracterización DC y RF de dispositivos	Análisis de las variaciones interanuales y estacionales: 5,71% Caracterización DC y RF de dispositivos electrónicos: 2,86% Caracterización de dispositivos fotovoltaicos: 2,86% Caracterización de pulsos ultracortos:	Análisis de las variaciones interanuales y estacionales: 6,45% Caracterización DC y RF de dispositivos electrónicos: 3,23% Caracterización de dispositivos fotovoltaicos: 3,23% Caracterización de pulsos ultracortos:

Curso	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	tecnología de THz: FETs de geometría de puerta no convencional. Nanohilos de Si y SiGe. Grafeno: 16,67% Micromecanizado o con pulsos láser ultracortos: 16,67% Modelización y simulación numérica de procesos dinámicos en nanoestructuras magnéticas: 16,67% Transistores de GaN para aplicaciones de potencia a alta frecuencia: 16,67%	Estudios de impactos de los escenarios climáticos en la agricultura: 15,38% Láseres ultraintensos y pulsos ultracortos: 7,69% Materiales y dispositivos para tecnología de THz: FETs de geometría de puerta no convencional. Nanohilos de Si y SiGe. Grafeno: 15,38% Micromecanizado o con pulsos láser ultracortos: 7,69% Modelización y simulación numérica de procesos dinámicos en nanoestructuras magnéticas: 23,08% Simulación Monte Carlo de dispositivos electrónicos semiconductores de alta frecuencia: 7,69% Transistores de GaN para aplicaciones de potencia a alta frecuencia: 7,69%	Estudios de impactos de los escenarios climáticos en la agricultura: 9,09% Láseres ultraintensos y pulsos ultracortos: 27,27% Materiales y dispositivos para tecnología de THz: FETs de geometría de puerta no convencional. Nanohilos de Si y SiGe. Grafeno: 13,64% Micromecanizado o con pulsos láser ultracortos: 4,55% Modelización y simulación numérica de procesos dinámicos en nanoestructuras magnéticas: 13,64% Propagación no lineal: 4,55% Resonancia ferromagnética: 4,55% Simulación Monte Carlo de dispositivos electrónicos semiconductores de alta frecuencia: 4,55% Transistores de GaN para aplicaciones de potencia a alta frecuencia: 7,69%	termoeléctricas usando Nanotecnología: 3,70% Estudios de impactos de los escenarios climáticos en la agricultura: 7,41% Fabricación y caracterización de dispositivos ópticos no lineales: 3,70% Fenómenos convectivos: 3,70% Láseres ultraintensos y pulsos ultracortos: 25,93% Materiales y dispositivos para tecnología de THz: FETs de geometría de puerta no convencional. Nanohilos de Si y SiGe. Grafeno: 14,81% Micromecanizado o con pulsos láser ultracortos: 3,70% Modelización y simulación numérica de procesos dinámicos en nanoestructuras magnéticas: 11,11% Optimización Termodinámica de Convertidores Energéticos: 3,70% Propagación no lineal: 7,41% Resonancia ferromagnética: 3,70% Simulación Monte Carlo de	Fabricación y caracterización de dispositivos ópticos no lineales: 3,70% Fenómenos convectivos: 3,70% Generación de armónicos de orden elevado: 11,11% Láseres ultraintensos y pulsos ultracortos: 22,22% Materiales y dispositivos para tecnología de THz: FETs de geometría de puerta no convencional. Nanohilos de Si y SiGe. Grafeno: 14,81% Micromecanizado o con pulsos láser ultracortos: 3,70% Modelización y simulación numérica de procesos dinámicos en nanoestructuras magnéticas: 11,11% Optimización Termodinámica de Convertidores Energéticos: 3,70% Propagación no lineal: 7,41% Resonancia ferromagnética: 3,70% Simulación Monte Carlo de	eléctricos: 3,57% Caracterización de dispositivos fotovoltaicos: 3,57% Desarrollo experimental de tecnologías fotovoltaicas y termoeléctricas usando Nanotecnología: 3,57% Fabricación y caracterización de dispositivos ópticos no lineales: 3,57% Fenómenos convectivos: 3,57% Generación de armónicos de orden elevado: 10,71% Láseres ultraintensos y pulsos ultracortos: 17,86% Materiales y dispositivos para tecnología de THz: FETs de geometría de puerta no convencional. Nanohilos de Si y SiGe. Grafeno: 14,29% Micromecanizado o con pulsos láser ultracortos: 3,57% Modelización y simulación numérica de procesos dinámicos en nanoestructuras	eléctricos: 3,33% Caracterización de dispositivos fotovoltaicos: 3,33% Caracterización de pulsos ultracortos: 3,33% Desarrollo experimental de tecnologías fotovoltaicas y termoeléctricas usando Nanotecnología: 3,33% Fabricación y caracterización de dispositivos ópticos no lineales: 6,67% Fenómenos convectivos: 3,33% Generación de armónicos de orden elevado: 16,67% Láseres ultraintensos y pulsos ultracortos: 13,33% Materiales y dispositivos para tecnología de THz: FETs de geometría de puerta no convencional. Nanohilos de Si y SiGe. Grafeno: 5,71% Micromecanizado o con pulsos láser ultracortos: 8,57% Modelización y simulación numérica de procesos dinámicos en nanoestructuras magnéticas: 8,57% MODFETs	2,86% Dispositivos electrónicos nanométricos: 2,86% Fabricación y caracterización de dispositivos ópticos no lineales: 5,71% Fenómenos convectivos: 2,86% Generación de armónicos de orden elevado: 14,29% Interacción láser-plasma: aceleración de partículas y excitación de núcleos: 5,71% Láseres ultraintensos y pulsos ultracortos: 14,29% Materiales y dispositivos para tecnología de THz: FETs de geometría de puerta no convencional. Nanohilos de Si y SiGe. Grafeno: 5,71% Micromecanizado o con pulsos láser ultracortos: 8,57% Modelización y simulación numérica de procesos dinámicos en nanoestructuras magnéticas: 8,57% MODFETs	3,23% Dispositivos electrónicos nanométricos: 3,23% Fabricación y caracterización de dispositivos ópticos no lineales: 3,23% Fenómenos convectivos: 3,23% Generación de armónicos de orden elevado: 12,90% Interacción láser-plasma: aceleración de partículas y excitación de núcleos: 6,45% Láseres ultraintensos y pulsos ultracortos: 9,68% Materiales y dispositivos para tecnología de THz: FETs de geometría de puerta no convencional. Nanohilos de Si y SiGe. Grafeno: 3,23% Micromecanizado o con pulsos láser ultracortos: 12,90% Modelización y simulación numérica de procesos dinámicos en nanoestructuras magnéticas: 9,68% MODFETs

Curso	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
			9,09%	lineal: 3,70% Resonancia ferromagnética: 3,70% Simulación Monte Carlo de dispositivos electrónicos semiconductores de alta frecuencia: 3,70% Transistores de GaN para aplicaciones de potencia a alta frecuencia: 3,70%	dispositivos electrónicos semiconductores de alta frecuencia: 3,70% Transistores de GaN para aplicaciones de potencia a alta frecuencia: 3,70%	magnéticas: 3,57% Optimización Termodinámica de Convertidores Energéticos: 3,57% Propagación no lineal: 7,14% Resonancia ferromagnética: 3,57% Simulación Monte Carlo de dispositivos electrónicos semiconductores de alta frecuencia: 3,57% Transistores de GaN para aplicaciones de potencia a alta frecuencia: 7,14%	de Convertidores Energéticos: 6,67% Propagación no lineal: 6,67% Resonancia ferromagnética: 6,67% Transistores de GaN para aplicaciones de potencia a alta frecuencia: 6,67%	nanométricos para emisión y detección de señales de THz con ondas de plasma: 2,86% Optimización Termodinámica de Convertidores Energéticos: 5,71% Propagación no lineal: 5,71% Transistores de GaN para aplicaciones de potencia a alta frecuencia: 2,86%	nanométricos para emisión y detección de señales de THz con ondas de plasma: 3,23% Optimización Termodinámica de Convertidores Energéticos: 6,45% Propagación no lineal: 3,23% Termodinámica y Física Estadística de Líquidos: 3,23% Transistores de GaN para aplicaciones de potencia a alta frecuencia: 3,23%
Criterio 4. Personal Académico									
Número de directores de tesis defendidas	-	2	2	3	7	4	14	7	1
Media de sexenios totales de los profesores del programa de doctorado (se dan desde el curso 2019-20 en adelante)	-	-	-	-	2,98	3,45	3,62	3,49	3,50
Porcentaje de sexenios vivos de los directores de tesis defendidas (se dan desde el curso 2019-20 en adelante)	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Criterio 6. Resultados de aprendizaje									
Porcentaje de tesis con calificación cum-laude	-	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%
Porcentaje de doctores con mención internacional	-	0,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	40,00%	0,00%

Curso	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Criterio 7. Indicadores de rendimiento y satisfacción									
Tasa de éxito	40,00%	57,14%	9,09%	16,67%	75,00%	20,00%	-	-	-
Número de tesis defendidas a tiempo completo	-	1	1	2	4	1	6	2	1
Duración media en cursos del programa de doctorado a tiempo completo	-	1,00	2,00	3,50	3,50	5,00	5,00	4,00	5,00
% de abandono del programa de doctorado a tiempo completo	-	-	-	33,33%	-	-	20,00%	14,29%	-
Número de tesis defendidas a tiempo parcial	-	-	-	-	-	1	2	3	-
Duración media en cursos del programa de doctorado a tiempo parcial	-	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	-
% de abandono del programa de doctorado a tiempo parcial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satisfacción de los doctorandos con los estudios: Media y Desv. Típica (escala 1 a 10)	no disponible	no disponible	no disponible	8,4 (1,3)	9,0 (1,2)	-	8,47 (1,29)	-	7,67 (1,99)
Satisfacción del profesorado con los estudios: Media y Desv. Típica (escala 1 a 10)	no disponible	no disponible	no disponible	8,0 (1,0)	8,2 (2,3)	-	8,21 (1,90)	-	8,41 (1,79)

Nota: datos obtenidos por la UEC a partir del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIU) y de información proporcionada por los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado.

Definiciones

Demanda: número de solicitudes presentadas para acceder a un programa de doctorado.

Estudiantes matriculados de nuevo ingreso: número de estudiantes de un programa de doctorado que, por primera vez, han formalizado la matrícula.

Número total de estudiantes matriculados: número total de estudiantes que en un curso determinado han formalizado su matrícula en el programa de doctorado.

Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados: relación entre el número de estudiantes de nacionalidad extranjera que han formalizado su matrícula en un programa de doctorado y el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado.

Porcentaje de estudiantes procedentes de estudios de otras universidades: relación entre el número de estudiantes que no proceden de estudios de grado y/o máster de la misma universidad y el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado

Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial: relación entre el número de estudiantes que han formalizado su matrícula en el programa de doctorado a los que se les ha autorizado a desarrollar el trabajo de tesis a tiempo parcial y el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado.

Porcentaje de becas de doctorado concedidas: relación entre el número de becas concedidas en el curso indicado y el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado.

Porcentaje de estudiantes según requerimientos de acceso: relación entre el número de estudiantes matriculados a los que se ha requerido cursar complementos de formación específica y el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado.

Porcentaje de estudiantes según línea de investigación: relación entre el número de estudiantes matriculados en cada línea concreta de investigación del programa de doctorado y el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado.

Número de directores de tesis defendidas número de profesores que han dirigido tesis doctorales que han sido defendidas en el programa de doctorado.

Media de sexenios totales: promedio de sexenios totales obtenidos por los profesores del programa de doctorado

Porcentaje de sexenios vivos de los directores de tesis: relación entre el número total de sexenios vivos de los profesores que han dirigido tesis doctorales que han sido defendidas en el programa de doctorado en el curso académico de referencia y el número total de directores de tesis del programa de doctorado leídas en dicho curso.

Porcentaje de tesis con mención cum laude: relación entre el número de tesis calificadas cum laude y el número de tesis defendidas en un mismo curso académico

Porcentaje de tesis con mención internacional: relación entre el número de tesis defendidas que han dado lugar a títulos de doctor con mención “doctorado internacional” y el número de tesis defendidas en un mismo curso académico.

Tasa de éxito. Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de la tesis en 4 años o menos, respecto al total de estudiantes que inician estudios de doctorado en el curso indicado en la columna.

Número de tesis defendidas a tiempo completo. Número de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a tiempo completo.

Duración media del programa de doctorado a tiempo completo. Promedio de cursos empleados por los estudiantes a tiempo completo que han defendido la tesis, desde que se matricularon por primera vez en el programa de doctorado.

Porcentaje de abandono del programa de doctorado de estudiantes a tiempo completo: relación entre el número de estudiantes que durante un curso académico ni han formalizado la matrícula en el programa de doctorado que cursaban ni han defendido la tesis y el número total de estudiantes a tiempo completo que iniciaron estudios en el curso indicado en la columna.

Número de tesis defendidas a tiempo parcial: Número de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a los que se les ha autorizado a desarrollarlo a tiempo parcial.

Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial: promedio de cursos académicos empleados por los estudiantes a los que se ha autorizado a desarrollarlo a tiempo parcial que han defendido la tesis, desde que se matricularon por primera vez en el programa de doctorado.

Porcentaje de abandono del programa de doctorado de estudiantes a tiempo parcial: relación entre el número de estudiantes a tiempo parcial que durante un curso académico ni han formalizado la matrícula en el programa de doctorado que cursaban ni han defendido la tesis y el número total de estudiantes a tiempo parcial que iniciaron estudios en el curso indicado en la columna.